



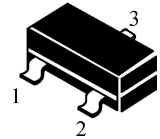
# 安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

**S8550**

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■ 最大額定值(T<sub>a</sub>=25°C)

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V <sub>CBO</sub>	-40	Vdc
Collect-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V <sub>CEO</sub>	-25	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V <sub>EBO</sub>	-5.0	Vdc
Collector Current 集電極電流	I <sub>c</sub>	-500	mAdc
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P <sub>C</sub>	225	mW
Junction Temperature 結溫	T <sub>j</sub>	150	°C
Storage Temperature Range 儲存溫度	T <sub>stg</sub>	-55~150	°C

■ DEVICE MARKING 打標

S8550=2TY

## S8550

### ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

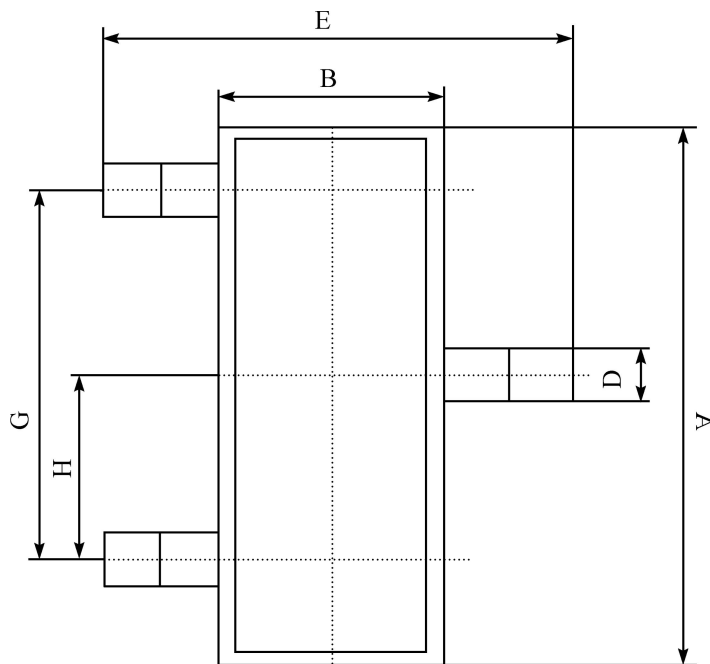
( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明, 溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$	—	—	-0.1	$\mu\text{A}$
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$	—	—	-0.1	$\mu\text{A}$
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-100\mu\text{A}$	-40	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10\text{mA}$	-25	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-100\mu\text{A}$	-5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	$H_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	85	—	400	—
	$H_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-500\text{mA}$	40	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$	—	—	-0.6	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	$V_{BE}$	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-10\text{mA}$	—	-0.8	-1.0	V
Transition Frequency 特徵頻率	$f_T$	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-10\text{mA}$	100	120	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	$C_{ob}$	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	13	30	pF

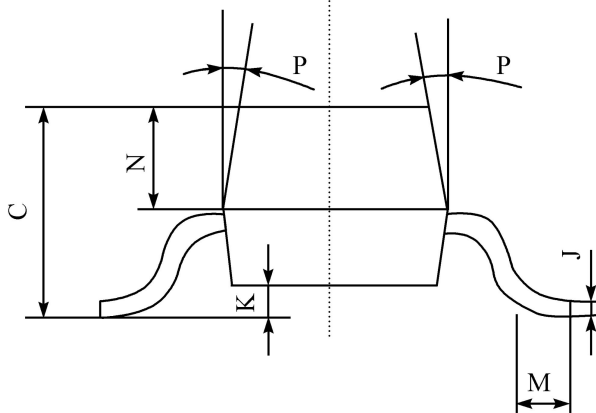
## S8550

### ■ DIMENSION 外形封装尺寸

單位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):*

*Click to view products by [FOSAN manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)  
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC5488A-TL-H](#)  
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)  
[MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#) [FP204-](#)  
[TL-E](#) [NJL0302DG](#) [2N3583](#) [2SA2014-TD-E](#) [2SC2812-5-TB-E](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#)